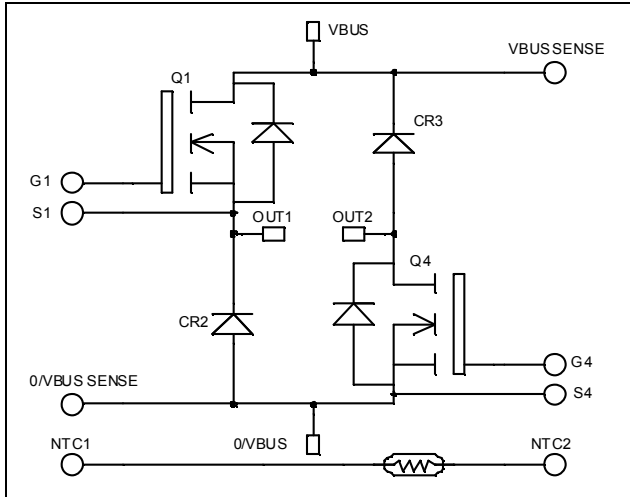


## Asymmetrical - Bridge MOSFET Power Module

$V_{DSS} = 200V$   
 $R_{DSon} = 16m\Omega \text{ typ @ } T_j = 25^\circ C$   
 $I_D = 104A \text{ @ } T_c = 25^\circ C$

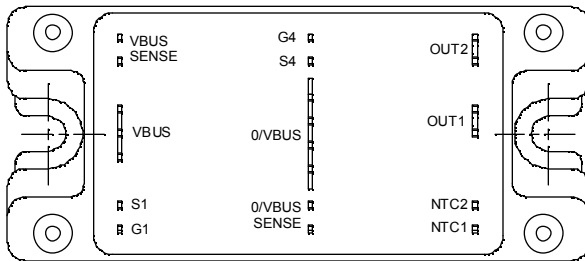


### Application

- Welding converters
- Switched Mode Power Supplies
- Switched Reluctance Motor Drives

### Features

- Power MOS 7<sup>®</sup> MOSFETs
  - Low  $R_{DSon}$
  - Low input and Miller capacitance
  - Low gate charge
  - Avalanche energy rated
  - Very rugged
- Kelvin source for easy drive
- Very low stray inductance
  - Symmetrical design
  - Lead frames for power connections
- Internal thermistor for temperature monitoring
- High level of integration



### Benefits

- Outstanding performance at high frequency operation
- Direct mounting to heatsink (isolated package)
- Low junction to case thermal resistance
- Solderable terminals both for power and signal for easy PCB mounting
- Low profile
- RoHS Compliant

### Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Max ratings	Unit
$V_{DSS}$	Drain - Source Breakdown Voltage	200	V
$I_D$	Continuous Drain Current	$T_c = 25^\circ C$	104
		$T_c = 80^\circ C$	77
$I_{DM}$	Pulsed Drain current	416	A
$V_{GS}$	Gate - Source Voltage	$\pm 30$	V
$R_{DSon}$	Drain - Source ON Resistance	19	$m\Omega$
$P_D$	Maximum Power Dissipation	$T_c = 25^\circ C$	390
$I_{AR}$	Avalanche current (repetitive and non repetitive)	104	A
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy	50	mJ
$E_{AS}$	Single Pulse Avalanche Energy	3000	

These Devices are sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed. See application note APT0502 on [www.microsemi.com](http://www.microsemi.com)

All ratings @  $T_j = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified

**Electrical Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 200\text{V}$			250	$\mu\text{A}$
		$V_{GS} = 0\text{V}, V_{DS} = 160\text{V}$			1000	
$R_{DS(on)}$	Drain – Source on Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}, I_D = 52\text{A}$		16	19	$\text{m}\Omega$
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{GS} = V_{DS}, I_D = 2.5\text{mA}$	3		5	V
$I_{GSS}$	Gate – Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$			$\pm 100$	nA

**Dynamic Characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0\text{V}$ $V_{DS} = 25\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		7220		pF
$C_{oss}$	Output Capacitance			2330		
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance			146		
$Q_g$	Total gate Charge	$V_{GS} = 10\text{V}$ $V_{Bus} = 100\text{V}$ $I_D = 104\text{A}$		140		nC
$Q_{gs}$	Gate – Source Charge			53		
$Q_{gd}$	Gate – Drain Charge			67		
$T_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	<b>Inductive switching @ <math>125^\circ\text{C}</math></b> $V_{GS} = 15\text{V}$ $V_{Bus} = 133\text{V}$ $I_D = 104\text{A}$ $R_G = 5\Omega$		32		ns
$T_r$	Rise Time			64		
$T_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			88		
$T_f$	Fall Time			116		
$E_{on}$	Turn-on Switching Energy	<b>Inductive switching @ <math>25^\circ\text{C}</math></b> $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 133\text{V}$ $I_D = 104\text{A}, R_G = 5\Omega$		849		$\mu\text{J}$
$E_{off}$	Turn-off Switching Energy			929		
$E_{on}$	Turn-on Switching Energy	<b>Inductive switching @ <math>125^\circ\text{C}</math></b> $V_{GS} = 15\text{V}, V_{Bus} = 133\text{V}$ $I_D = 104\text{A}, R_G = 5\Omega$		936		$\mu\text{J}$
$E_{off}$	Turn-off Switching Energy			986		

**Diode ratings and characteristics**

Symbol	Characteristic	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$V_{RRM}$	Maximum Peak Repetitive Reverse Voltage		200			V
$I_{RM}$	Maximum Reverse Leakage Current	$V_R = 200\text{V}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$		250	$\mu\text{A}$
			$T_j = 125^\circ\text{C}$		500	
$I_F$	DC Forward Current			100		A
$V_F$	Diode Forward Voltage	$I_F = 100\text{A}$		1	1.1	V
		$I_F = 200\text{A}$		1.4		
		$I_F = 100\text{A}$	$T_j = 125^\circ\text{C}$	0.9		
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$I_F = 100\text{A}$ $V_R = 133\text{V}$ $di/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$	$T_j = 25^\circ\text{C}$	60		ns
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	110		
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		$T_j = 25^\circ\text{C}$	200		nC
			$T_j = 125^\circ\text{C}$	840		

## Thermal and package characteristics

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit	
R <sub>thJC</sub>	Junction to Case Thermal Resistance	Transistor		0.32	°C/W	
		Diode		0.55		
V <sub>ISOL</sub>	RMS Isolation Voltage, any terminal to case t=1 min, I <sub>isol</sub> <1mA, 50/60Hz	2500			V	
T <sub>J</sub>	Operating junction temperature range	-40		150	°C	
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range	-40		125		
T <sub>C</sub>	Operating Case Temperature	-40		100		
Torque	Mounting torque	To Heatsink	M5	2.5	4.7	N.m
Wt	Package Weight				160	g

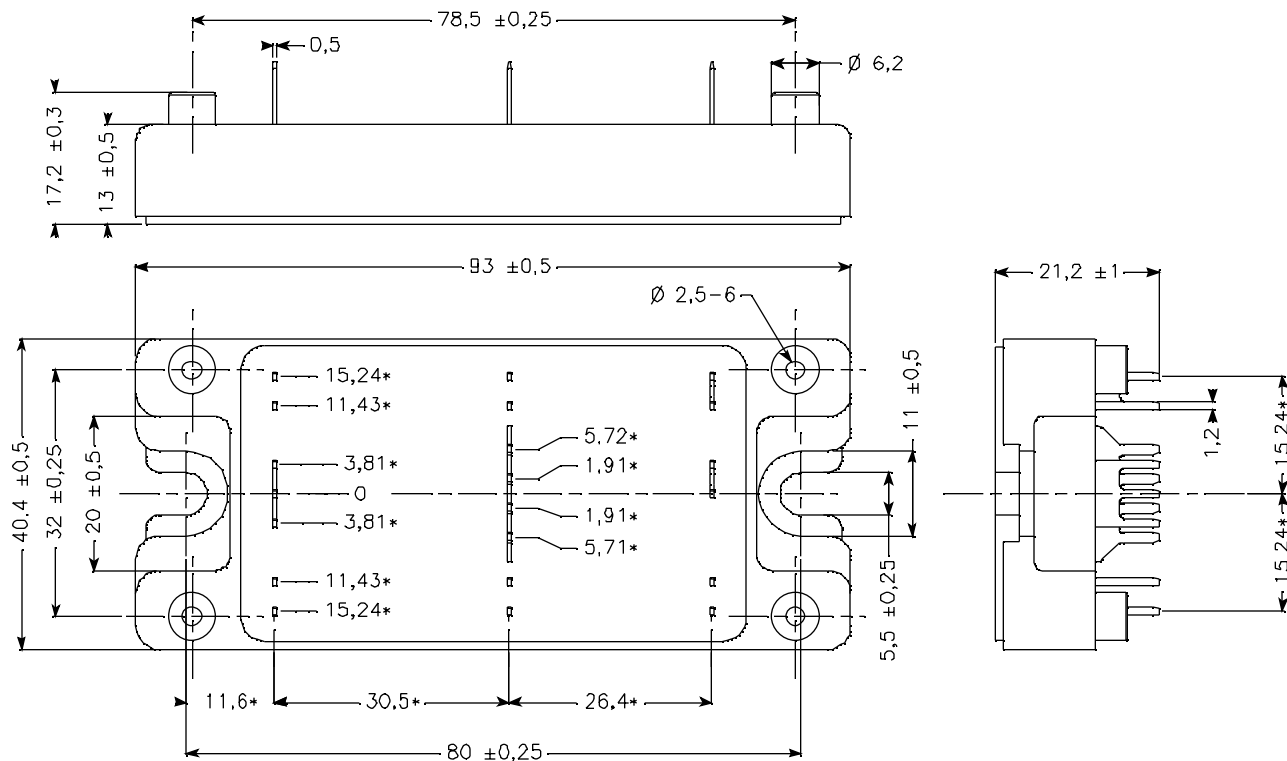
## Temperature sensor NTC (see application note APT0406 on www.microsemi.com for more information).

Symbol	Characteristic	Min	Typ	Max	Unit
R <sub>25</sub>	Resistance @ 25°C		50		kΩ
B <sub>25/85</sub>	T <sub>25</sub> = 298.15 K		3952		K

$$R_T = \frac{R_{25}}{\exp\left[B_{25/85}\left(\frac{1}{T_{25}} - \frac{1}{T}\right)\right]}$$

T: Thermistor temperature  
 R<sub>T</sub>: Thermistor value at T

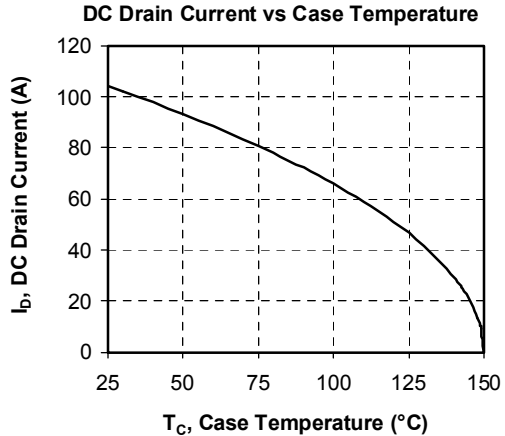
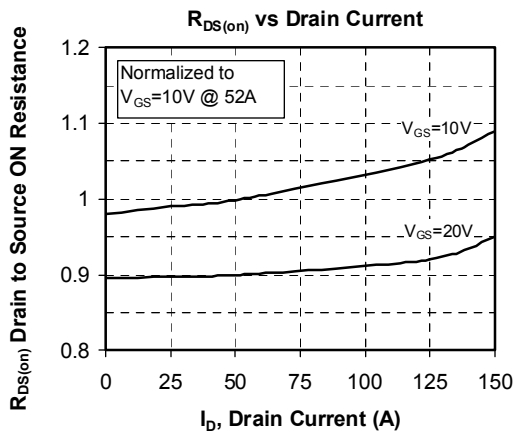
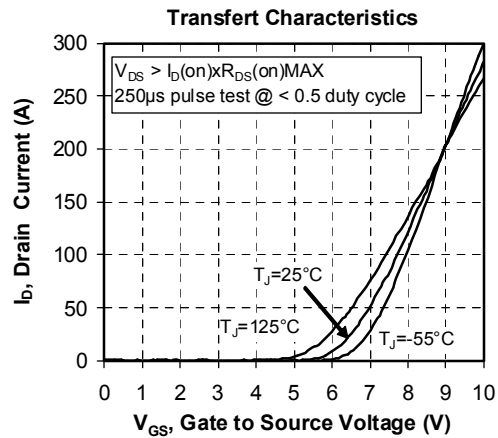
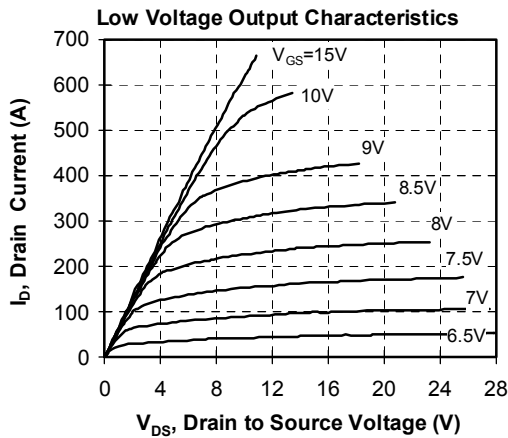
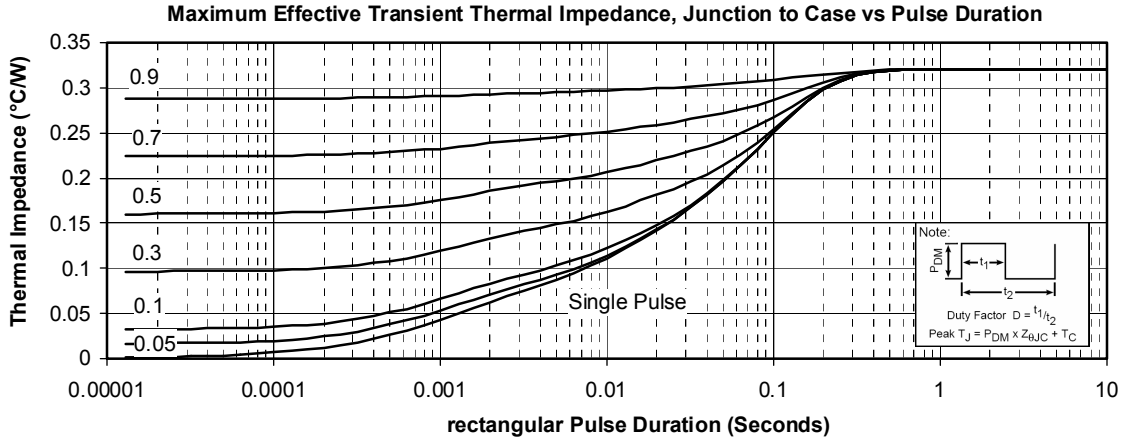
## SP4 Package outline (dimensions in mm)

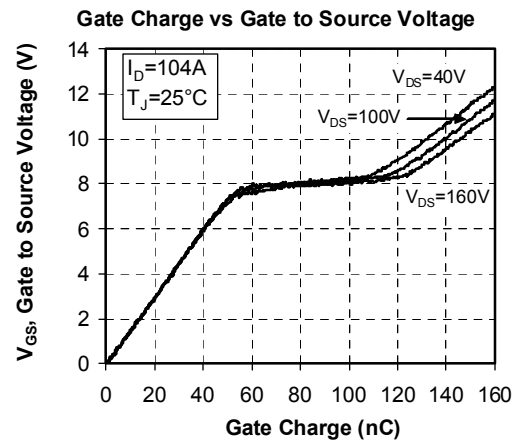
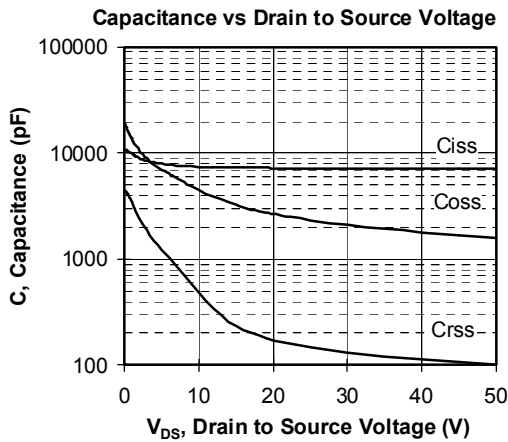
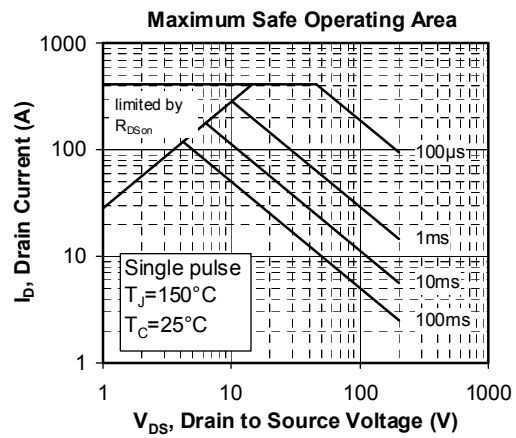
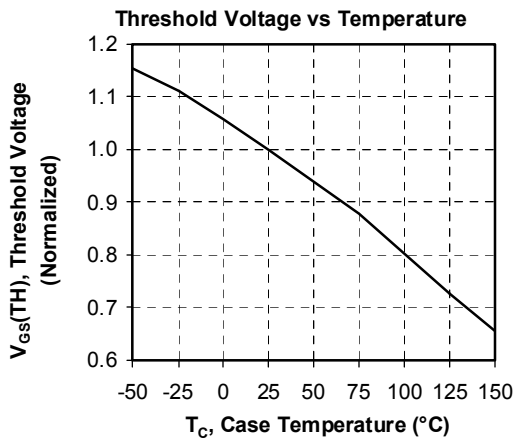
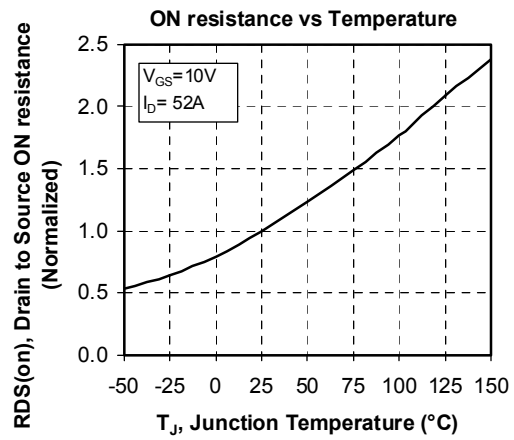
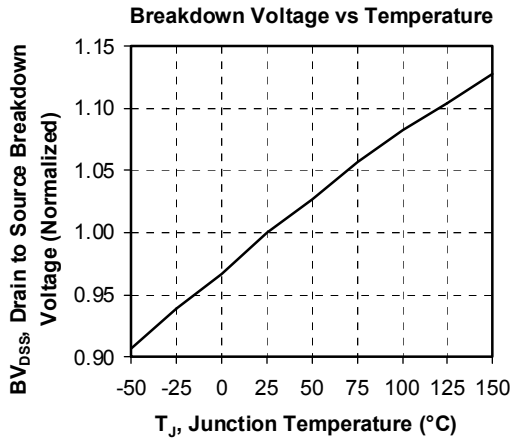


ALL DIMENSIONS MARKED "\*" ARE TOLERANCED AS:  $\pm 0.1$

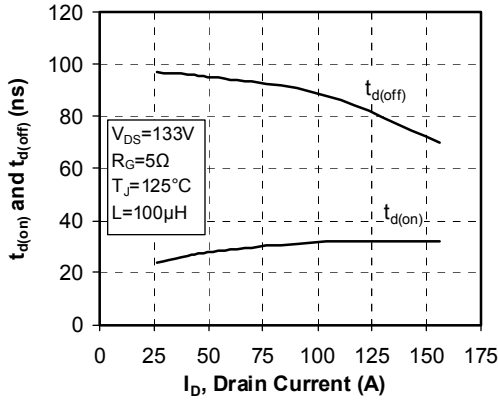
See application note APT0501 - Mounting Instructions for SP4 Power Modules on www.microsemi.com

## Typical Performance Curve

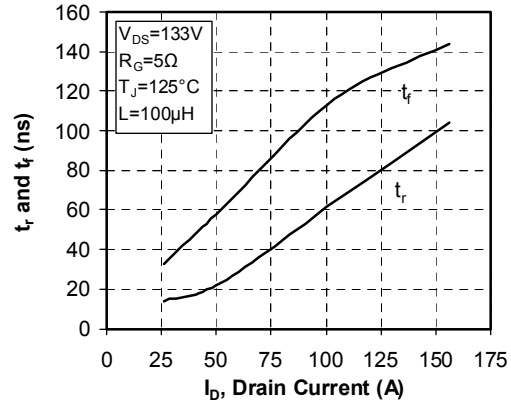




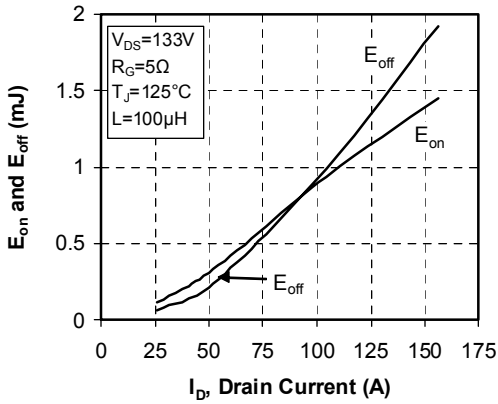
**Delay Times vs Current**



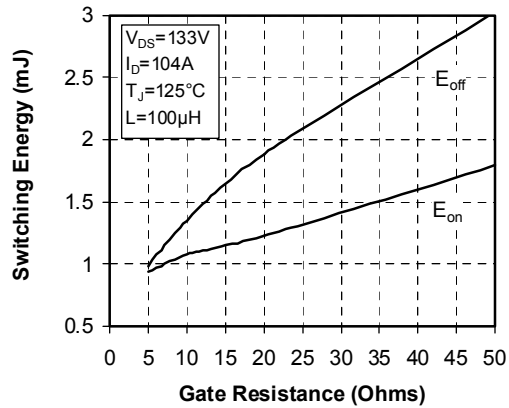
**Rise and Fall times vs Current**



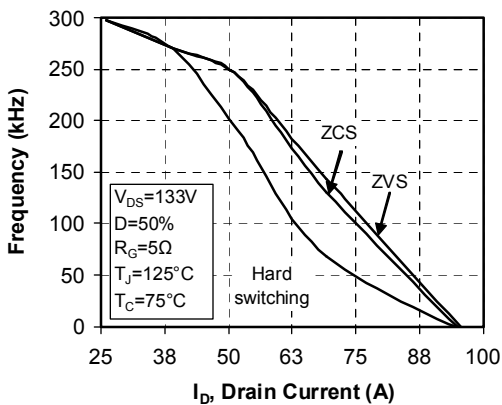
**Switching Energy vs Current**



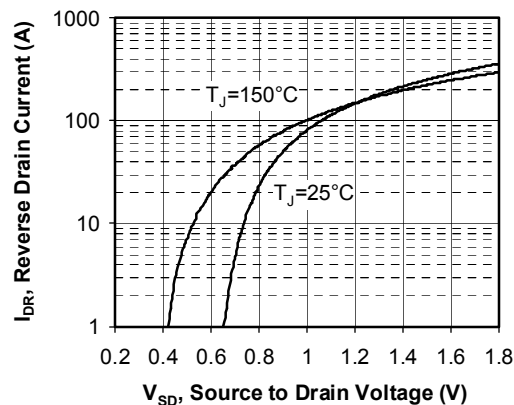
**Switching Energy vs Gate Resistance**



**Operating Frequency vs Drain Current**



**Source to Drain Diode Forward Voltage**



Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein

Microsemi's products are covered by one or more of U.S. patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 and foreign patents. U.S. and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Поставка электронных компонентов

**Юридический адрес организации:**  
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.  
**Фактический адрес организации:**  
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.  
ИНН 780277764  
КПП 780501001  
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703  
БИК 044030703  
**Телефон:** 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)  
**Факс:** 8 (812) 309-44-11  
**Электронная почта:** [sales@timechips.ru](mailto:sales@timechips.ru)  
**Сайт:** [timechips.ru](http://timechips.ru)

## Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

**Миссия** – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

**Наша цель** – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

**Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!**

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты ([www.taisaw.com](http://www.taisaw.com))

TRANSCOM СВЧ-компоненты ([www.transcominc.com.tw](http://www.transcominc.com.tw))

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты ([minicircuits.com](http://minicircuits.com))

SAMTEC- разъемы ([www.samtec.com](http://www.samtec.com))

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения ([converterdc.com/](http://converterdc.com/))

**Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.**

**«ТаймЧипс» - это:**

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

**Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника** – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

**В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:**

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

*С Уважением, Чернов Павел.*

*Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"*

*Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).*

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

**Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141**

**Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152**

**Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65**

**Skype: time.chips5**

**Электронная почта: [manager1@timechips.ru](mailto:manager1@timechips.ru)**

---